

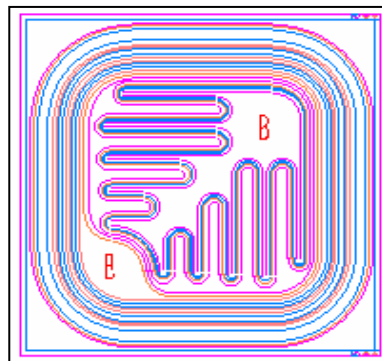


13003 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：D180BG-00
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：1800×1800μm²
焊位尺寸：B 极 320×320μm²，E 极 200×300μm²
电极金属：铝
背面金属：银
典型封装：KSE13003，HE13003

管芯示意图

极限值 (T_a=25℃) (封装形式：TO-126/220)

T _{stg}	— 贮存温度	-65~150℃
T _j	— 结温	150℃
P _C	— 集电极功率耗散 (T _c =25℃)	40W
V _{CBO}	— 集电极—基极电压	700V
V _{CEO}	— 集电极—发射极电压	400V
V _{EBO}	— 发射极—基极电压	9V
I _C	— 集电极电流 (DC)	1.5A
I _B	— 基极电流	0.75A

电参数 (T_a=25℃) (封装形式：TO-126/220)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	I _C =5mA, I _B =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			10	μA	V _{EB} =9V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	10		40		V _{CE} =5V, I _C =0.5A
		5				V _{CE} =2V, I _C =1A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和压降			0.5	V	I _C =0.5A, I _B =0.1A
				1	V	I _C =1A, I _B =0.25A
				3	V	I _C =1.5A, I _B =0.5A
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和压降			1	V	I _C =0.5A, I _B =0.1A
				1.2	V	I _C =1A, I _B =0.25A
f _T	特征频率	5			MHz	V _{CE} =10V, I _C =0.1A, f=1MHz
t _{ON}	导通时间			1.1	μs	V _{CC} =125V, I _C =1A I _{B1} =-I _{B2} =0.2A R _L =125Ω
t _{STG}	贮存时间			4.0	μs	
t _F	下降时间			0.7	μs	